



KIOXIA, 2021 IEEE Andrew S. Grove 상 수상

2020 년 7 월 22 일

KIOXIA Corporation

2020 년 7 월 22 일, 도쿄 – 세계적인 메모리 솔루션의 리더 KIOXIA Corporation 은 오늘, KIOXIA 의 기술팀이 고밀도, 3 차원 플래시메모리에 대한 선도적 역할과 지속적인 공헌으로 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)로부터 2021 Andrew S. Grove Award 를 수상했다고 발표했습니다.

이 상은 솔리드-스테이트 장치 및 기술에서의 두드러진 공헌을 인정하는 것입니다. 수상팀원들은 KIOXIA 의 Institute of Memory Technology Research and Development 와 Advanced Memory Development Center 의 소속 입니다. 시상식은 2021 년 12 월 San Francisco 에서 열리는 IEDM(International Electron Device Meeting)에서 개최될 예정입니다.

2007 년, KIOXIA 는 BiCS FLASH™ 이라는 3D 플래시메모리 기술을 발표하였는데, 고밀도 3D 플래시메모리를 실현시키기 위해 메모리 셀을 수직으로 쌓아서 제조 공정을 크게 줄이는 획기적인 접근법이었습니다. 기존의 적층 방식에서는 메모리 셀 어레이 제작을 위해 반복적인 박막 증착(deposition)과 패턴 공정(patterning processes)이 필요했지만, BiCS FLASH™ 기술은 먼저 메모리 셀의 재료를 쌓고, 한번의 패턴 공정으로 각 셀을 동시에 만들어 공정 단계를 획기적으로 줄입니다. 오늘날 널리 사용되는 3D 플래시메모리는 KIOXIA 의 BiCS FLASH™ 컨셉에 기반한 것입니다.

3D 플래시메모리를 완성시키려는 KIOXIA 의 끊임없는 헌신 덕분에 이 기술은 플래시메모리 응용분야를 확대시키고, 더 작은 다이(die)로 더 큰 용량의 제품 수요를 충족시켰습니다.

앞으로도 KIOXIA 는 정보 기반 산업의 선진화를 이끄는 데 도움을 줄 수 있는 플래시메모리 기술을 개발하는데 기여할 것입니다.



KIOXIA 의 2021 IEEE Andrew S. Grove Award 수상자

Hideaki AOCHI

Senior Expert, Institute of Memory Technology Research and Development

Ryota KATSUMATA

Deputy General Manager, Advanced Memory Development Center

Masaru KITO

Group Manager, Advanced Memory Development Center